


	<h2>SI5980DU-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI5980DU-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 100V 2.5A CHIPFET</p> <p>Datenblätter:  SI5980DU-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI5980DU-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 100V 2.5A CHIPFET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® ChipFet Dual
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	567 mOhm @ 400mA, 10V
Leistung - max	7.8W
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® ChipFET™ Dual
Andere Namen	SI5980DU-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	78pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	3.3nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 100V 2.5A 7.8W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.5A
Basisteilenummer	SI5980

SI5980DU-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5980DU-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5980DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI5980DU-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI5975DC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 12V 3.1A CHIPFET</p>	 <p>SI5999EDU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 6A POWERPAK</p>	 <p>SI5997DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 30V 6A PPAK CHIPFET</p>	 <p>SI5975DC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 12V 3.1A CHIPFET</p>
 <p>SI5980DU-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 100V 2.5A CHIPFET</p>	 <p>SI5975DC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 12V 3.1A CHIPFET</p>	 <p>SI5XX-EVB Energy Micro (Silicon Labs) BOARD EVAL FOR XO/VCXO SGL/DUAL</p>	 <p>SI5999EDU-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 6A POWERPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI5980DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI5980DU-T1-GE3 Datenblatt	SI5980DU-T1-GE3-Datenblätter	SI5980DU-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI5980DU-T1-GE3
SI5980DU-T1-GE3 Electronic	SI5980DU-T1-GE3-Komponenten	SI5980DU-T1-GE3-Verteiler	SI5980DU-T1-GE3-Bild	SI5980DU-T1-GE3-Teil
SI5980DU-T1-GE3 Preis	SI5980DU-T1-GE3 Hersteller	SI5980DU-T1-GE3 Bild	SI5980DU-T1-GE3 Aktie	SI5980DU-T1-GE3 Inventar
SI5980DU-T1-GE3 Neu	SI5980DU-T1-GE3 Original	SI5980DU-T1-GE3 garantiert	SI5980DU-T1-GE3 RFQ	SI5980DU-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited